

来聴歓迎！！

加藤・山崎記念寄付金 特別講演会 省エネ・パワー半導体 SiC の 進展と将来展望

木本 恒暢 氏

京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授

日時:2016年1月25日(月)10時45分~12時00分

場所:京田辺キャンパス 恵道館 KD106 教室

講演内容

SiC(炭化珪素)は広い禁制帯幅を有する半導体であり、次世代の低損失・電力用半導体材料として注目されている。SiC は結晶成長やプロセス技術が困難であったが、近年の研究により大型の高純度・高品質単結晶が得られるようになり、物性解明や欠陥制御、デバイスプロセスの研究が急速に進展している。また、これを元にして、小規模ながら SiC パワーデバイスの実用化が始まり、顕著な省エネ効果を実証している。本講演では、SiC 半導体の特徴、結晶成長、物性評価、パワーデバイスの作製と応用について概説する。



加藤・山崎記念寄付金

加藤与五郎博士の主張される「学問の新しい流れを創る研究、新しい工業を創成する独創的な研究」を実践できる若い研究者を育成するための、山崎舜平氏による寄付金。



主催：同志社大学ハリス理化学研究所 加藤・山崎記念寄付金運営委員会

共催：同志社大学理工学部，生命医科学部，脳科学研究科，リエゾンオフィス

問い合わせ先：同志社大学ハリス理化学研究所事務室 (TEL:0774-65-6220)